



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种在SiC衬底背面制备欧姆接触的方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310589191.5
申请日期:	2013-11-20
专利号:	201310589191.5
第一发明人:	韩林超;申华军;白云;汤益丹;许恒宇;王弋宇;杨谦;刘新宇
实施情况:	授权
专利证书号:	201310589191.5
其它备注:	高频高压中心

